



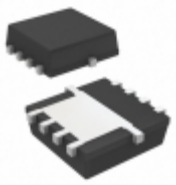
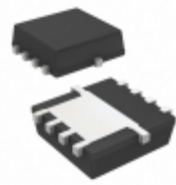




	<h2>SI7820DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7820DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7820DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4265 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7820DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4265 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 1.7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	240 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7820DN-T1-GE3TR

SI7820DN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7820DN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7820DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7820DN-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7840BDP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7840</b> SI SI7840 SI</p>	 <p><b>SI7820DN-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8</p>	 <p><b>SI7820DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8</p>
 <p><b>SI7840BDP</b> SI SI7840BDP SI</p>	 <p><b>SI7840BDP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7818DN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p>	 <p><b>SI7820DN</b> SI SI7820DN SI</p>

heiße Teile

Mehr

SI7804DN-T1-E3	SI7806ADN	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3-PBF
SI7806ADN-T1-GE3	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3	SI7806BDN	SI7806BDN-T1-GE3
SI7806DN-T1-E3	SI7806DN-T1-GE3	SI7810DN	SI7810DN-T1	SI7810DN-T1-E
SI7810DN-T1-E3	SI7810DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-GE3
SI7812DN-T1-GE3	SI7818DN-T1-E3	SI7818DN-T1-E3	SI7820DN-T1-E3	SI7820DN-T1-E3
SI7820DN-T1-GE3	SI7840BDP	SI7840BDP-T1-E3	SI7840BDP-T1-E3	SI7840BDP-T1-GE3
SI7840BDP-T1-GE3	SI7840DP	SI7840DP-T1	SI7840DP-T1-E3	SI7840DP-T1-GE3
SI7840DP-T1-GE3	SI7842DP	SI7842DP-T1-E3	SI7842DP-T1-E3	SI7842DP-T1-GE3
SI7842DP-T1-GE3	SI7844DP	SI7844DP-T1	SI7844DP-T1-E3	SI7844DP-T1-E3
SI7844DP-T1-GE3	SI7844DP-T1-GE3	SI7846DP	SI7846DP-T1-E3	SI7846DP-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited